

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE

Patent Number: JP59208756
Publication date: 1984-11-27
Inventor(s): AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02
Applicant(s): SONY KK
Requested Patent: JP59208756
Application Number: JP19830083188 19830512
Priority Number(s):
IPC Classification: H01L23/12 ; H01L21/56 ; H01L23/48
EC Classification:
Equivalents: JP1760995C, JP4047977B

Abstract

PURPOSE: To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching.

CONSTITUTION: Au plating 12 of 1μm thickness, Ni plating 13 of 1μm thickness and Au plating 14 of 3μm are laminated on an Fe substrate 11 of 35μm thickness. A semiconductor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness $t=1\text{mm}$. The Fe substrate is removed by etching with FeCl_3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In order to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑯ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑯ 公開特許公報 (A)

昭59-208756

⑤ Int. Cl.³
H 01 L 23/12
21/56
23/48

識別記号

府内整理番号
7357-5F
7738-5F
7357-5F

⑬ 公開 昭和59年(1984)11月27日
発明の数 1
審査請求 未請求

(全 5 頁)

⑭ 半導体装置のパッケージの製造方法

35号ソニー株式会社内

⑯ 特 願 昭58-83188

⑯ 発明者 梶山雄次

⑯ 出 願 昭58(1983)5月12日

東京都品川区北品川6丁目7番

⑯ 発明者 秋山克彦

35号ソニー株式会社内

東京都品川区北品川6丁目7番

⑯ 出願人 ソニー株式会社

35号ソニー株式会社内

東京都品川区北品川6丁目7番

⑯ 発明者 小野鉄雄

35号

東京都品川区北品川6丁目7番

⑯ 代理人 弁理士 土屋勝

外2名

明細書

1. 発明の名称

半導体装置のパッケージの製造方法

2. 特許請求の範囲

選択エッティング可能な材料から成る基板上に半導体接続部を載置し、接続用ワイヤを上記半導体装置に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部電極部を上記基板の外部電極接続部位に接続し、次いで上記基板上において上記半導体装置及び上記接続用ワイヤを一体に樹脂モールドし、かかる後上記基板をエッティング除去することを特徴とする半導体装置のパッケージの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、半導体装置のパッケージの製造方法に関する。

背景技術とその問題点

従来、プリント基板上の実装密度の高いパッケージとして、チップキャリアタイプのパッケージが知られている。このパッケージはリードレス

タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き出されているハンダ付け可能な電極をプリント基板の導体パターンに直接ハンダ付けして接続することにより実装を行うものである。

このチップキャリアタイプパッケージには、セラミックタイプとプラスチックタイプとがある。セラミックタイプはパッケージ自体が高価であるばかりでなく、プリント基板に直接ハンダ付けすると、温度サイクル時にセラミックと上記ハンダ及び上記導体との間の熱膨張係数の差によって接続部にはがれやクラックが生じる恐れがあるという欠点を有している。一方、プラスチックタイプはパッケージが安価であるという利点を有しているが、熱放散性が悪く、また形状がパッケージの製造の自動化に適していないという欠点を有している。

このような従来のプラスチックタイプのチップキャリアタイプパッケージの構造を第1図に示す。このパッケージ(1)は、銅箔製の電極(2)が予め形成されているプリント基板(3)上に半導体装置を構成

するチップ(4)を載置し、ワイヤボンディング法により上記チップ(4)と上記電極(2)の一端とをAuの細線から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より液状のエポキシ樹脂を滴下させて硬化成形することによつて作る。

このパッケージ(1)において、チップ(4)は樹脂層(6)とプリント基板(3)とによつて囲まれている。これらの樹脂層(6)及びプリント基板(3)の熱抵抗は共に大きいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果的に放散することができない。即ち、このパッケージ(1)は放熱性が悪いという欠点を有している。また上記の液状のエポキシ樹脂を滴下する際に、微量の樹脂を一定量、しかも高速で滴下することが難しく、このためにパッケージ(1)はパッケージの製造の自動化に適していないという欠点を有している。

一方、上述のチップキャリアタイプパッケージとは異なるパッケージにテープキャリアタイプパッケージがある。このタイプのパッケージは従来のチップキャリアタイプパッケージよりもさらに

小形化できるという利点を有するが、チップが樹脂層によつて完全に覆われているため熱放散性が良好でないこと、テープを用いているために特殊な装置が必要である等の欠点を有している。

発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、熱放散性が良好でかつ信頼性の高い半導体装置のパッケージの製造方法を提供することを目的とする。

発明の概要

本発明に係る半導体装置のパッケージの製造方法は、選択エッティング可能な材料から成る基板上に半導体装置を載置し、接続用ワイヤを上記半導体装置に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部電極部端を上記基板の外部電極接続部位に接続し、次いで上記基板上において上記半導体装置及び上記接続用ワイヤを一体に樹脂モールドし、かかる後上記基板をエッティング除去するようにしている。このようにすることによつて、熱放散性が良好でかつ信頼性の高いリードレスタイプのパッケージを、簡便かつ安価な方法によつて自動的に製造す

ることができる。なお上記外部電極部は上記接続用ワイヤ自身が兼ねていてもよいし、上記接続用ワイヤとは別に設けられかつ上記接続用ワイヤが接続されているものでもよい。

実施例

以下本発明に係る半導体装置のパッケージの製造方法の実施例につき図面を参照しながら説明する。

第2A図～第2D図は本発明の第1実施例による半導体装置のパッケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第2A図から工程順に説明する。

まず第2A図において、厚さ35[μ]のFe製の基板4の上に、厚さ1[μ]のAu層4a、厚さ1[μ]のNi層4b及び厚さ3[μ]のAu層4cを順次メッキして、半導体装置を構成するチップ4の載置部4d及び外部電極部4eのそれを上記基板4の所定のチップ載置部位(11g)及び外部電極接続部位(11h)(11i)のそれぞれに設ける。第2A図に示す工程終了後の上記基板4の平面図を第

3図に示す。次に第2B図において、上記チップ載置部4dにチップ4を載置した後、ワイヤボンディング法によつてこのチップ4と上記外部電極部4eとをそれぞれAuの細線から成るワイヤ5で接続する。次に第2C図において、第2B図の基板4の上に設けられた上記外部電極部4e、チップ載置部4d、チップ4及びワイヤ5を一体とするために、公知のトランスファー・モールド法(移送成形法)を用いて、エポキシから成る樹脂モールド層6を上記基板4上に形成する。なお本実施例においては、上記樹脂モールド層6の厚さtを1[mm]とした。

次に第2C図において、Feのみを選択的にエッティングするが樹脂モールド層6及びAu層4aはエッティングしないエッティング液、例えは塩化第二鉄($FeCl_3$)溶液を用いて、基板4の裏面(11a)側からスプレー・エッティングすることにより、上記基板4を除去して、第2D図に示すリードレスタイプのパッケージ4を完成させる。上記エッティングによつて露出されたAu層4aの下面のうち外部

電極部切端の Au 層の下面が外部電極面 (12b) (12c) となり、またチップ載置部切端の Au 層の下面が熱放散面 (12a) となる。

上述のようにして完成されたパッケージ (2) をプリント基板上に実装する場合には、第 2 D 図に示す上記外部電極面 (12b) (12c) をプリント基板上の導体バタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。

上述の第 1 実施例の熱放散面 (12a) は、その動作時においてチップ (4) から発生する熱の放散面となつていて、金属の熱伝導度は非常に高いので、チップ (4) から発生する熱は金属製のチップ載置部 (16) を外方に向かつて迅速に流れて、熱放散面 (12a) から放散されることによつて効果的に除去される。しかし、より効果的にチップ (4) の発生熱を除去するためには、広い表面積を有する放熱フィンの一部を上記熱放散面 (12a) に押し当てて空冷により熱を放散させるのが好ましい。

上述の第 1 実施例のパッケージ (2) は第 2 A 図～第 2 D 図に示すような簡単な工程によつて作るこ

とができるばかりでなく、全ての製造工程に従来から用いられている装置を用いることができるので、テープキャリアタイプのパッケージにおいて必要な既述の特殊な装置が不要である。従つて、簡便かつ安価な方法によりパッケージ (2) を製造することができる。さらに上述の第 1 実施例では樹脂モールド層 (20) を形成する方法としてトランスマルト・モールド法(移送成形法)を用いている。この方法は信頼性の高い樹脂封止ができるばかりでなく、モールドの機械化、量産化が容易であるためにパッケージを自動的に製造できるという利点を有している。

なお上述の第 1 実施例において、第 2 A 図に示す場合と同様にチップ載置部 (16) 及び外部電極部 (18) を設けた後に、基板 (11) の上面を既述の $FeCl_3$ 溶液を用いて僅かにエッティングすることにより、第 4 A 図に示すようにチップ載置部 (16) 及び外部電極部 (18) の下部の基板 (11) にアンダーカット部 (11a) ～ (11f) を形成し、次に第 2 B 図～第 2 D 図と同様な方法によつて第 4 B 図に示すパッケージ (2) を

完成させることができる。このように上記のエッティングによつてチップ載置部 (16) 及び外部電極部 (18) の下部に上記アンダーカット部 (11a) ～ (11f) が形成されるので、これらの部分に樹脂が回り込んで突出部 (20a) ～ (20f) が形成される。従つてこれらの突出部 (20a) ～ (20f) によつて上記チップ載置部 (16) 及び上記外部電極部 (18) が下方から保持される構造となるので、上記チップ載置部 (16) 及び上記外部電極部 (18) がパッケージ (2) の使用時において樹脂モールド層 (20) から抜け出てしまうのを防止することができるという利点がある。さらにチップ載置部 (16) 及び外部電極部 (18) が樹脂モールド層 (20) の下面から突出することなく形成されるので、これらのチップ載置部 (16) 及び外部電極部 (18) を保護することができるという利点もある。

第 5 A 図～第 5 C 図は本発明の第 2 実施例による半導体装置のパッケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第 5 A 図から工程順に説明する。

まず第 5 A 図において、厚さ 35 [μ] の Cu

板の基板 (11) の上面に公知のフォトレジストを塗布した後に所定のバターンニングを行う。次いで Cu のみを選択的にエッティングするエッティング液、例えば既述の $FeCl_3$ 溶液を用いて上記基板 (11) の表面を僅かにエッティングすることによつて、上記基板 (11) の表面にチップ載置部位 (11g) 及び外部電極接続部位 (11h) (11i) をそれぞれ形成する。上記フォトレジストを除去した後に第 5 B 図において、第 1 実施例と同様に、上記チップ載置部位 (11g) にハンダ層 (20) を介してチップ (4) を載置した後、ワイヤボンディング法によつてこのチップ (4) と上記外部電極接続部位 (11h) (11i) とをそれぞれ Ag の細線から成るワイヤ (19) で接続する。なお本実施例においては、後述の理由により、第 1 実施例で用いたワイヤよりも径の大きいワイヤを用いた。次に第 1 実施例と同様に樹脂モールド層 (20) を上記基板 (11) 上に形成する。次に上記基板 (11) を第 1 実施例と同様な方法でエッティング除去してパッケージ (2) を完成させる。上記エッティングにより露出されたワイヤ (19) の端部が外部電極部 (18) となり、またハ

ンダ層の下面が熱放散面(23a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージ20をプリント基板上に実装する場合には、第1実施例と同様に、第5C図に示す上記外部電極部(17)をプリント基板上の導体バタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。このことから明らかなように、本実施例においてはワイヤ(5)の端部をそのまま外部電極部(17)として用いるために、ワイヤ(5)の径を既述のように大きくするのが好ましい。なお熱放散面(23a)の機能は第1実施例と同様である。

上述の第2実施例のパッケージ20は、第1実施例のパッケージ20と異なつて、フォトレジスト工程及びエッチング工程によって基板(11)に設けられた外部電極接続部位(11h)(11i)にワイヤ(5)を直接接続するようにしているので、第1実施例のパッケージ20におけるAu層(12)(14)及びNi層(13)を形成する必要がない。上記のフォトレジスト工程及びエッチング工程は第1実施例のパッケージ20で用いたメッキ工程よりもさらに簡便である。またこれらのフォトレジスト工程及びエッチング工程

を用いることにより、Au等の貴金属を用いる必要がなくなるという利点がある。

上述の第1実施例及び第2実施例においては、1個のチップをチップ載置部に載置してこれを樹脂モールドする場合につき述べたが、基板上に多数のチップ載置部を設け、それぞれのチップ載置部に同一のチップを載置して、これらのチップを一体に樹脂モールドした後に切断分離することにより、それぞれ1個のチップを有する同一のパッケージを多数個同時に作ることもできる。また種々のチップと、コンデンサや抵抗等の受動素子とを基板上に載置した後にこれらを一体に樹脂モールドすれば、種々の機能を有するパッケージを作ることができると共に、回路素子の集成度の高いパッケージを作ることができるという利点がある。

上述の第1実施例の基板の材料は選択エッチングが可能であればCu等の他の金属であつてもよく、また第2実施例の基板の材料もFe等の他の金属であつてもよい。第1実施例においてはさらに金属以外の材料、例えばポリイミドアミド系樹

脂を用いることも可能である。この場合には既述のエッチング液としては、ヒドラジンとエチレンジアミンとの混合液を用いればよい。

発明の効果

本発明に係る半導体装置のパッケージの製造方法によれば、その動作時において半導体装置から発生する熱の放散性が良好でありかつ信頼性が高い小形のパッケージを、極めて簡便かつ安価な方法によって自動的に製造することができる。

4. 図面の簡単な説明

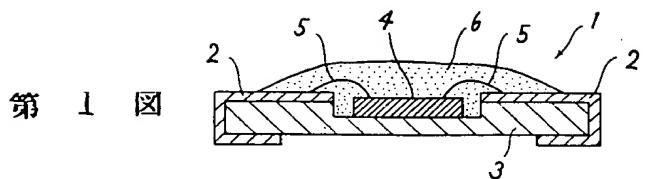
第1図は従来のプラスチックタイプのチップキャリアタイプパッケージの構造を示す断面図、第2A図～第2D図は本発明の第1実施例による半導体装置のパッケージの製造方法を説明するための工程図、第3図は上記第2A図に示す工程終了後の基板の平面図、第4A図及び第4B図は上記第1実施例の変形例を示す上記第2A図～第2D図と同様な図、第5A図～第5C図は本発明の第2実施例による半導体装置のパッケージの製造方法を説明するための工程図である。

なお図面に用いた符号において、

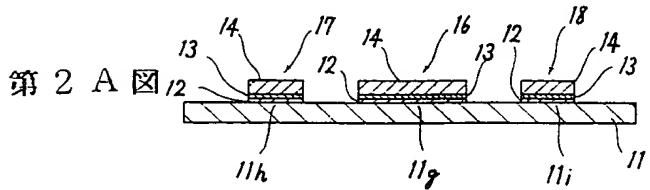
(1)(2)(3)(4)	パッケージ
(4)(5)	チップ
(5)(6)	ワイヤ
(11)	基板
(11h)(11i)	外部電極接続部位
(17)	外部電極部
(20)	樹脂モールド層

である。

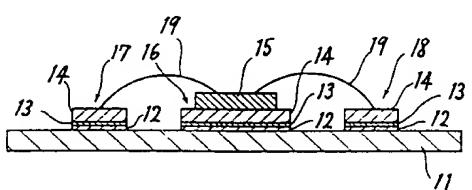
代 理 人	土 屋 勝
	常 包 芳 男
	杉 浦 俊 貴



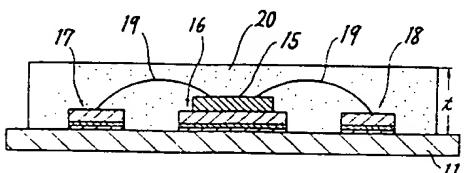
第一図



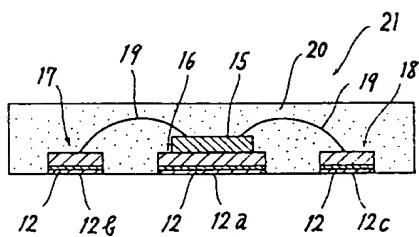
第2B図



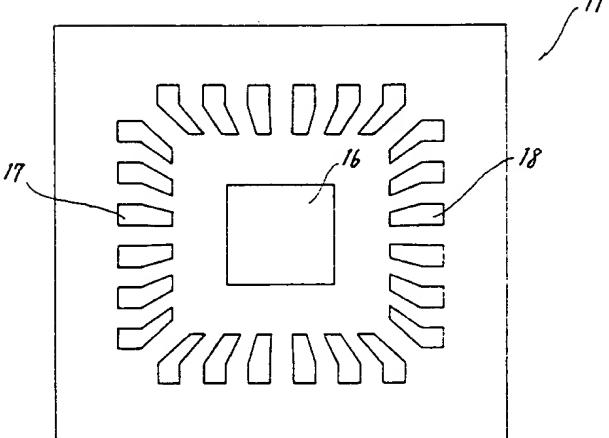
第2C図



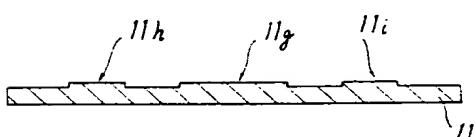
第2D図



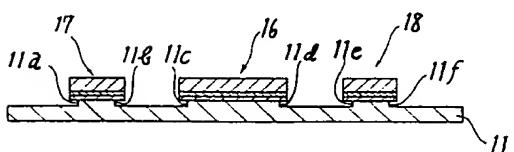
第3回



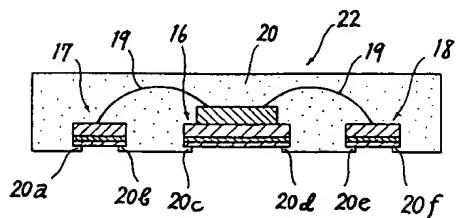
第5A図



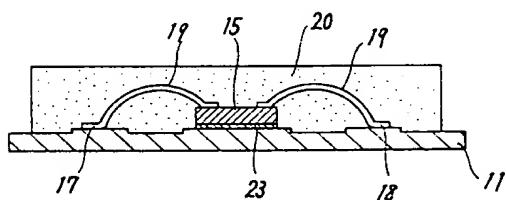
第 4 A 図



第4B図



第5B図



第 5 C 図

